

三菱半導体(トランジスタ)
2SB1035

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャル形

概要

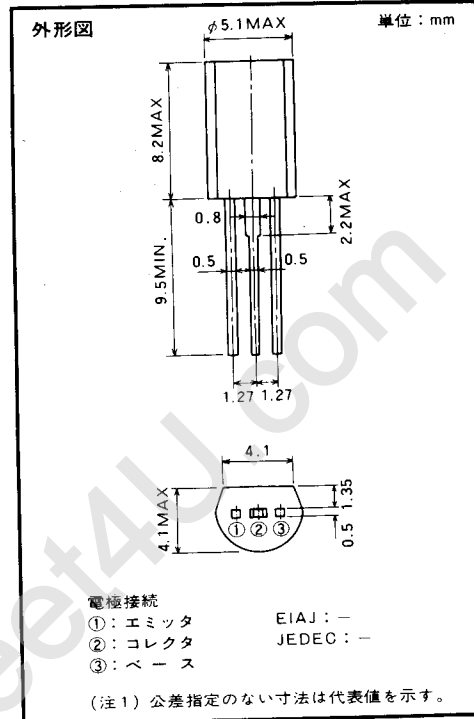
2SB1035は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタで、特にコレクタ損失およびコレクタ電流が大きく設計、製造されており、2~3.5W出力の低周波電力増幅用として2SD1447とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特長

- コレクタ損失が大きい $P_{Cmax}=900mW$
- コレクタ電流が大きい $I_{CM}=-1.5A$
- h_{FE} の直線性がよい
- 利得帯域幅積が高い $f_T=100MHz$ 標準

用途

ラジオ、テープレコーダ、小形ステレオ等の2~3.5W出力の低周波電力増幅回路



最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

記号	項目	定格値	単位
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-30	V
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-4	V
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-25	V
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-1.5	A
I_C	コレクタ電流	-1	A
P_C	コレクタ損失 ($T_a=25^\circ C$)	900	mW
T_j	接合部温度	+150	$^\circ C$
T_{stg}	保存温度	-55 ~ +150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C=-10\mu A, I_E=0$	-30		-	V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=-10\mu A, I_C=0$	-4		-	V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=-100\mu A, R_{BE}=\infty$	-25		-	V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB}=-25V, I_E=0$			-1	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB}=-2V, I_C=0$			-1	μA
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE}=-1V, I_C=-500mA$	55		300	
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C=-500mA, I_B=-25mA$			-0.5	V
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE}=-6V, I_E=10mA$		100		MHz

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55~110	90~180	150~300